

RB435C

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

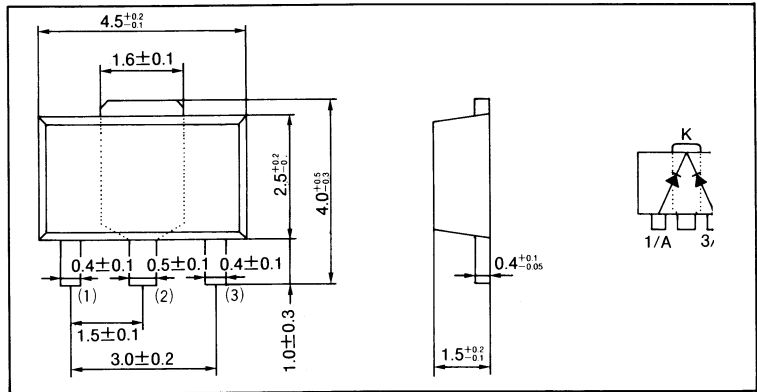
● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

● 用途

一般整流用

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● Applications

For general rectification

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V_{RM}	20	V
直流逆電圧	V_R	10	V
平均整流電流*1	I_O	0.5	A
尖頭サージ電流*2	I_{FSM}	3	A
動作接合温度範囲	T_j	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-40 ~ +125	°C

*1 Single phase, Resistive load 60Hz, Ta = 25°C

*2 60Hz · 1 ~

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
順方向電圧	V_F	—	—	0.55	V	$I_F = 0.5A$
逆方向電圧	I_R	—	—	30	μA	$V_R = 10V$
端子間容量	C_t	—	20	—	pF	$V_R = 10V, f = 1MHz$

● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

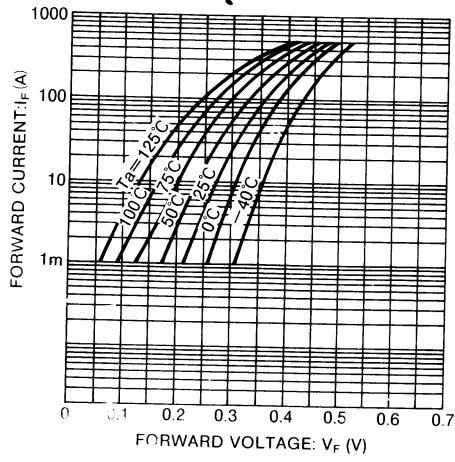


Fig. 1 順方向温度特性

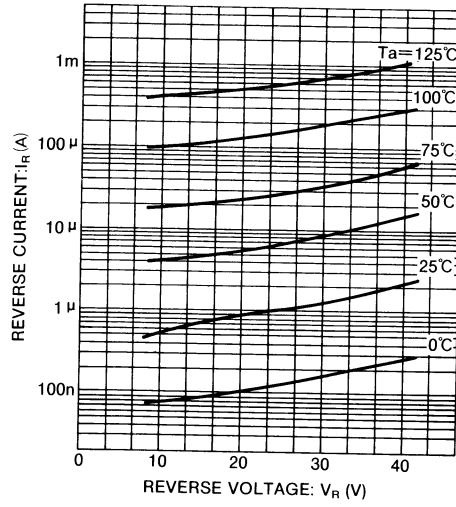


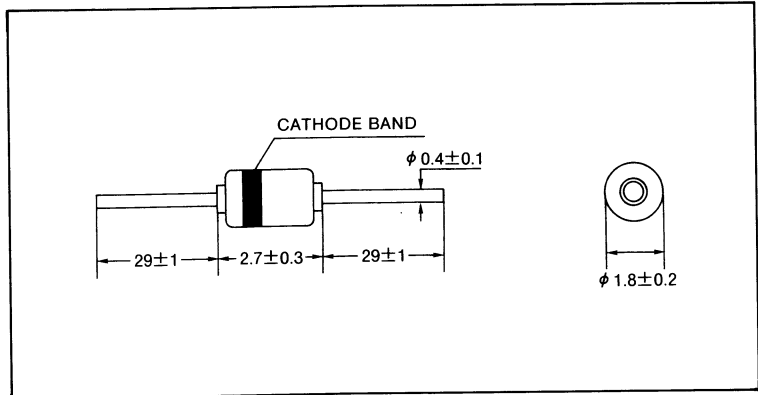
Fig. 2 逆方向温度特性

ダイオード

ショットキーバリアダイオード

RB441Q (開発中/Under Development)シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード
Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 特長

- 1) 超小型である。
- 2) 小ピッチで基板挿入が可能。
- 3) 高信頼性である。

● Features

- 1) Ultrasmall type
- 2) PCB is insertable in small pitches
- 3) High reliability

● 用途

小電流整流用

● Applications

For rectifying small current

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V _{RM}	20	V
直流逆電圧	V _R	10	V
平均整流電流	I _O	0.1	A
尖頭サージ電流*	I _{FSM}	1	A
動作接合温度範囲	T _j	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T _{stg}	-40 ~ +125	°C

*60Hz・1〜

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I _R	—	—	10	μA	V _R = 10V
順方向電圧	V _F	—	—	0.55	V	I _F = 100mA
端子間容量	C _t	—	6.0	—	pF	V _R = 10V, f = 1MHz

RB450F (開発中/Under Development)

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

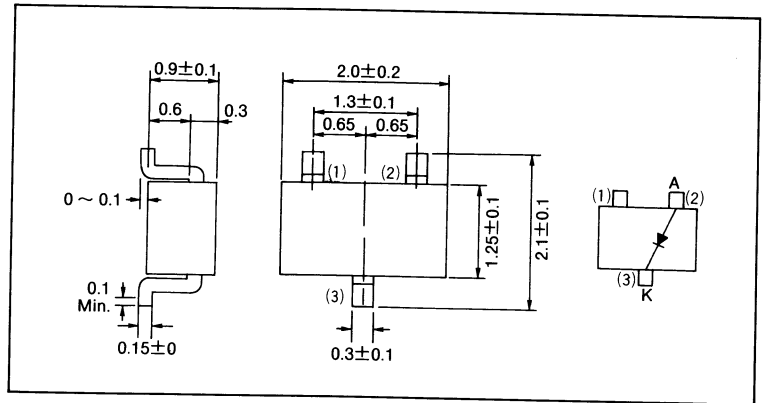
● 用途

小電流整流用

● Applications

For rectifying small current

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V_{RM}	25	V
直流逆電圧	V_R	20	V
平均整流電流	I_O	0.1	A
尖頭サージ電流*	I_{FSM}	1	A
動作接合温度範囲	T_j	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-40 ~ +125	°C

*60Hz・1〜

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I_R	—	—	1	μA	$V_R = 10V$
順方向電圧	V_F	—	—	0.45	V	$I_F = 10mA$
端子間容量	C_t	—	6.0	—	pF	$V_R = 10V, f = 1MHz$

RB451F

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

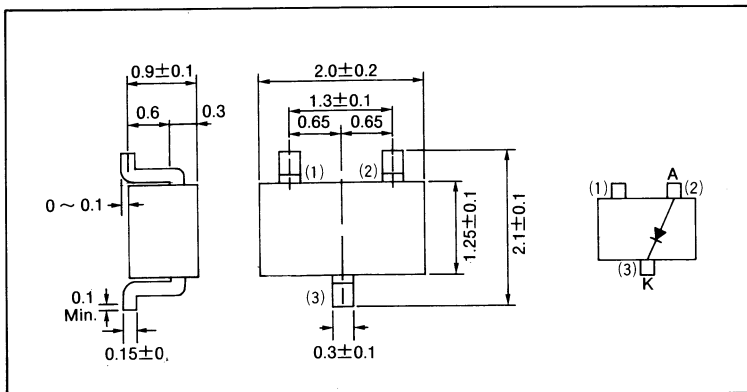
● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)

● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability



● 用途

小電力整流用

● Applications

For rectifying small power

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V _{RM}	20	V
平均整流電流	I _O	0.1	A
尖頭サージ電流*	I _{FSM}	1	A
動作接合温度範囲	T _j	- 40 ~ + 125	°C
保存温度範囲	T _{stg}	- 40 ~ + 125	°C

*60Hz・1〜

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I _R	—	—	30	μA	V _R = 10V
順方向電圧	V _{F1}	—	—	0.55	V	I _F = 100mA
	V _{F2}	—	—	0.34	V	I _F = 10mA
端子間容量	C _t	—	6.0	—	pF	V _R = 10V, f = 1MHz

● 電気的特性曲線/Electrical Characteristic Curves

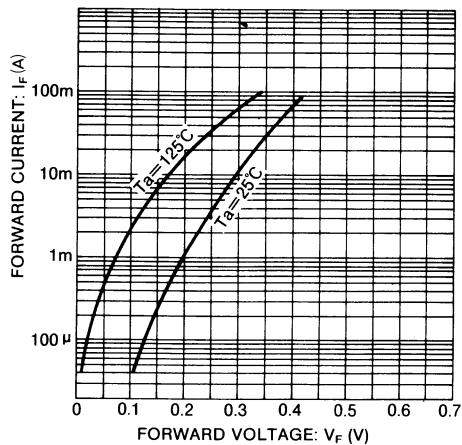


Fig. 1 順方向温度特性

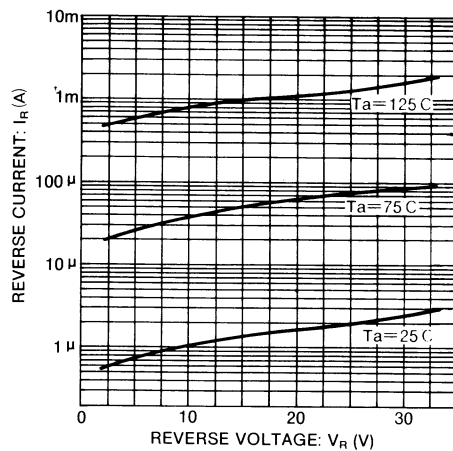


Fig. 2 逆方向温度特性

RB471E

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

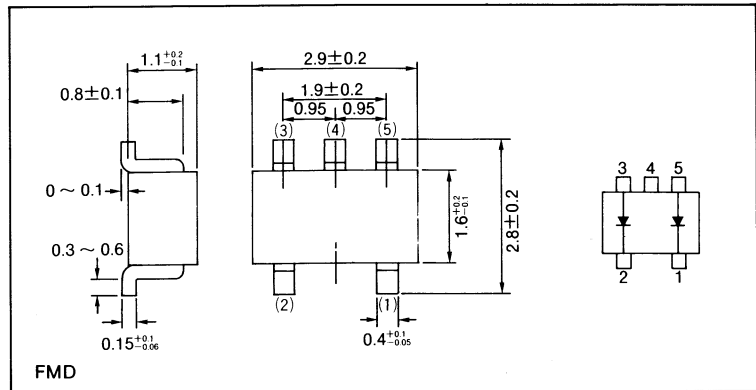
● 特長

- 1) ミニモールドタイプ。
- 2) 小型である。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Minimold type
- 2) Small size
- 3) High reliability

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 用途

小電流整流用

● Applications

For rectifying small current

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V _{RM}	20	V
直流逆電圧	V _R	10	V
平均整流電流	I _O	0.1	A
尖頭サージ電流*	I _{FSM}	1	A
動作接合温度範囲	T _J	- 40 ~ + 125	°C
保存温度範囲	T _{stg}	- 40 ~ + 125	°C

*60Hz・1〜

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I _R	—	—	30	μA	V _R = 10V
順方向電圧	V _{F1}	—	—	0.55	V	I _F = 100mA
	V _{F2}	—	—	0.34	V	I _F = 10mA
端子間容量	C _t	—	6.0	—	pF	V _R = 10V, f = 1MHz

● 電気的特性曲線 / Electrical Characteristic Curves

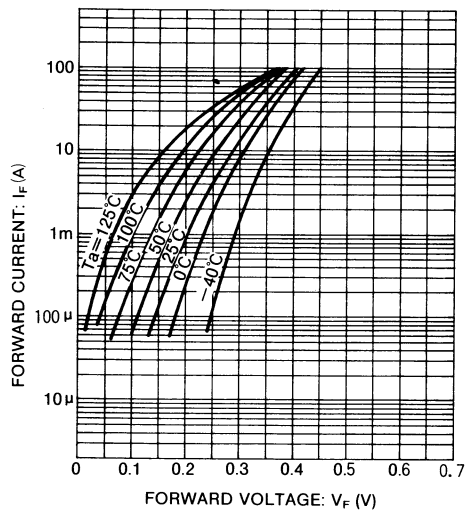


Fig. 1 順方向温度特性

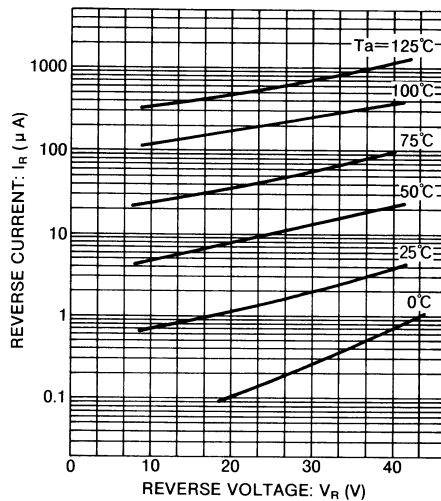


Fig. 2 逆方向温度特性

RB705D (開発中/Under Development)

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) カソード共通ツインタイプ。
- 2) ミニモールド。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Cathode-common twin type
- 2) Minimold
- 3) High reliability

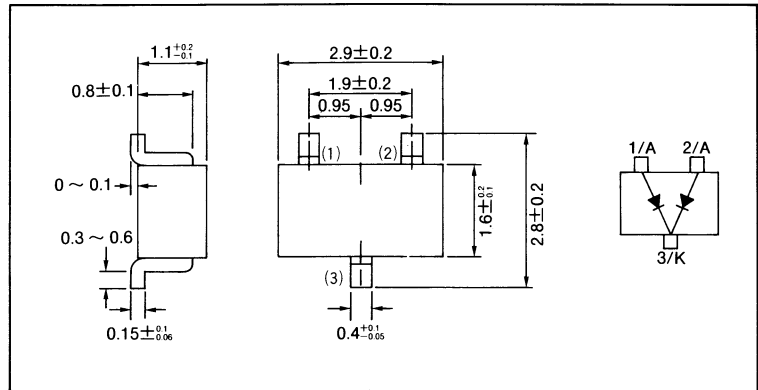
● 用途

- 一般検波用
高速スイッチング用

● Applications

For general rectification and high-speed switching

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V _{RM}	25	V
直流逆電圧	V _R	20	V
平均整流電流	I _O	30	mA
尖頭サージ電流*	I _{FSM}	200	mA
動作接合温度範囲	T _J	- 40 ~ + 125	°C
保存温度範囲	T _{stg}	- 40 ~ + 125	°C

*60Hz · 1 ~

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I _R	—	—	1	μA	V _R = 10V
順方向電圧	V _F	—	—	0.37	V	I _F = 1mA
端子間容量	C _t	—	2.0	—	pF	V _R = 1V, f = 1MHz

RB715F

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

● 特長

- 1) カソード共通ツインタイプ。
- 2) ミニモールド。
- 3) 高信頼度である。

● Features

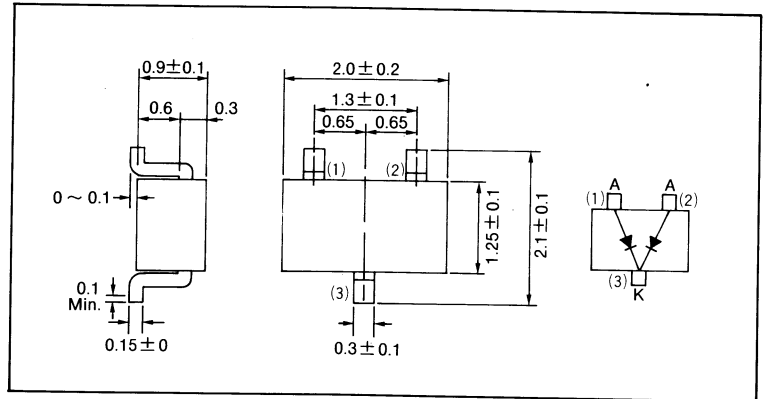
- 1) Cathode-common twin type
- 2) Minimold
- 3) High reliability

● 用途

一般検波用

高速スイッチング用

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● Applications

For general detection and high-speed switching

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V_{RM}	25	V
直流逆電圧	V_R	20	V
平均整流電流	I_O	30	mA
尖頭サージ電流*	I_{FSM}	200	mA
動作接合温度範囲	T_j	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$
保存温度範囲	T_{stg}	-40 ~ +125	$^\circ\text{C}$

*60Hz・1～

● 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I_R	—	—	1	μA	$V_R = 10\text{V}$
順方向電圧	V_F	—	—	0.37	V	$I_F = 1\text{mA}$
端子間容量	C_t	—	2.0	—	pF	$V_R = 1\text{V}, f = 1\text{MHz}$

RB717F (開発中/Under Development)

シリコンエピタキシャル形ショットキーバリアダイオード Silicon Epitaxial Schottky Barrier Diode

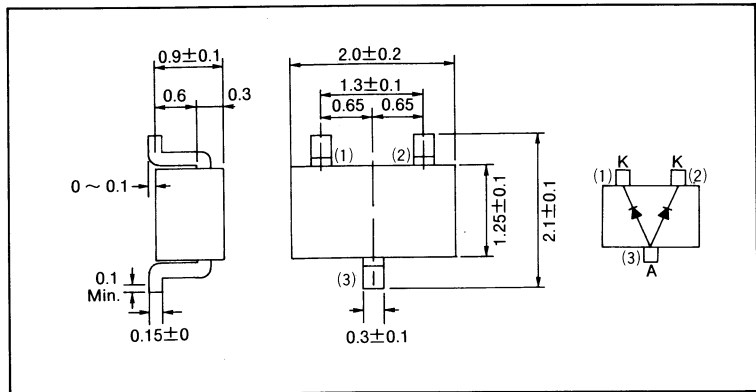
● 特長

- 1) アノード共通ツインタイプ。
- 2) ミニモールド。
- 3) 高信頼度である。

● Features

- 1) Anode-common twin type
- 2) Minimold
- 3) High reliability

● 外形寸法図/Dimensions (Unit : mm)



● 用途

- 一般検波用
- 高速スイッチング

● Applications

For general detection and high-speed switching

● 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits	Unit
繰り返しピーク逆電圧	V_{RM}	25	V
直流逆電圧	V_R	20	V
平均整流電流	I_O	30	mA
尖頭サージ電流*	I_{FSM}	200	mA
動作接合温度範囲	T_J	-40 ~ +125	°C
保存温度範囲	T_{stg}	-40 ~ +125	°C

*60Hz・1〜

● 電気的特性/Electrical Characteristics (Ta = 25°C)

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Conditions
逆方向電流	I_R	—	—	1	μA	$V_R = 10V$
順方向電圧	V_F	—	—	0.37	V	$I_F = 1mA$
端子間容量	C_t	—	2.0	—	pF	$V_R = 1V, f = 1MHz$